

بستگی ترابرد گرمایی به تعداد لایه در نانونوارهای گرافینی زیگزاگ و آرمچیر

على مهرى، مريم جماعتى، رضا پهلوان يلى

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

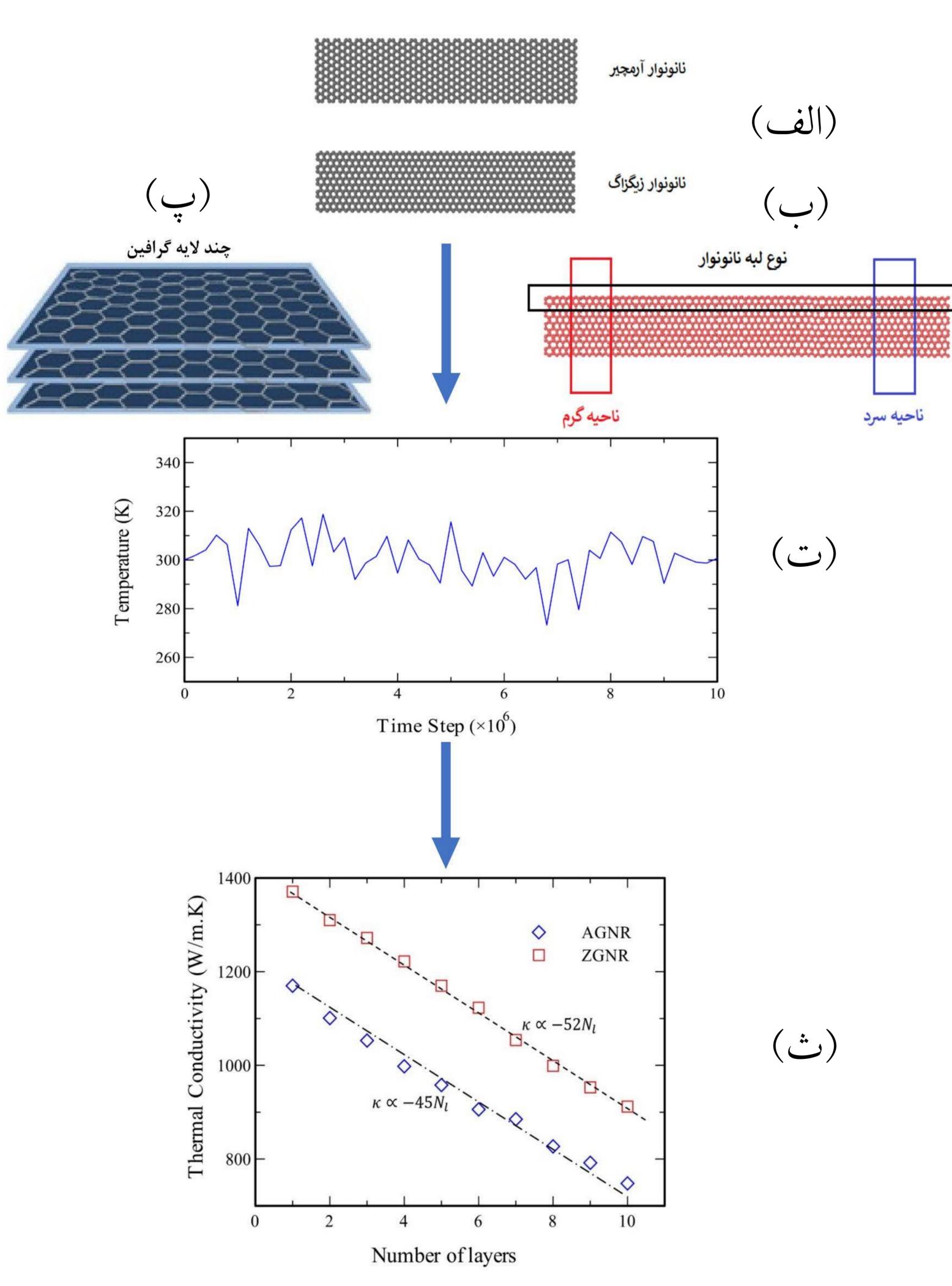
نتايج

همان طور که در تصویر مشاهده می کنیم رسانش گرمایی در هر دو نوع نانونوار با افزایش تعداد لایه کاهش می یابد. اگرچه کاهش رسانش در نانونوار گرافینی زیگزاگ با نرخ بزرگتری نسبت به نانونوار آرمچیر رخ می دهد. این کاهش رسانش را می توان به تشدید مدهای فونونی بیرون صفحه ای نسبت داد. این رفتار با رفتار رسانش گرمایی گزارش شده توسط کائو و همکارانش سازگاری دارد [3]. جزیبات روش محاسباتی می تواند در نتیجه اثرگذار باشد، اما رفتار رسانش بر حسب عوامل مختلف را به طور یکسان تخمین می زند. همچنین نتایج نشان می دهند که رسانش گرمایی در نانونوارهای زیگزاگ مقدار بیشتری نسبت به نانونوارهای آرمچیر دارند، که با بررسیهای نظری انجام شده سازگاری دارند. لازم به ذکر است بررسیهای آزمایشگاهی نشان داده اند که عوامل بسیاری از جمله کیفیت نمونه، دمای اعمال شده و استراتژی آزمایش بر نتایج بسیار اثر گذار هستند [۵].

ىراجع

- [1] M.M. Sadeghi, M.T. Pettes and L. Shi; "Thermal Transport in Graphene"; Solid State Communications 152(15) (2012) 1321-1330.
- [2] A.A. Balandin, S. Ghosh, W. Bao, I. Calizo, D. Teweldebrhan, F. Miao and C.N. Lau; "Superior Thermal Conductivity of Single-Layer Graphene"; Nano Letters, 8(3) (2008) 902-907.
- [3] M.H. Begum, M. Muhtashim, S.M. Jiban, T.I. Toriq and A.Z. Mamun; "Temperature Dependent Thermal Conductivity of Graphene Nanoribbon (GNR) for Different Interatomic Potentials: An Equilibrium Molecular Dynamics Study'; International Conference on Computer, Communication, Chemical, Materials and Electronic Engineering (IC4ME2), IEEE (2019).
- [4] H.Y. Cao, Z.X. Guo, H.G. Xiang and X.G. Gong; "Layer and Size Dependence of Thermal Conductivity in Multilayer Graphene Nanoribbon"; Physics Letters A 376 (2012) 525-528.
- [5] J.H. Zou, Z.Q. Ye and B.Y. Cao; "Phonon Thermal Properties of Graphene from Molecular Dynamics using Different Potentials"; The Journal of Chemical Physics 145(13) (2016) 134705.

در این بررسی رسانش گرمایی دو نوع نانونوار زیگزاگ و آرمچیر با عرض ۲ نانومتر و طول ۱۰ نانومتر را با اعمال گرادیان دمایی ۵۰ کلوین در دمای اتاق و تعداد لایههای متفاوت محاسبه نمودیم. شکل زیر نمودار رسانش گرمایی را بر حسب اختلاف دمای دو سر نانولوله، برای دو نوع نانولولهی مذکور نمایش می دهد.



الف) نانونوارهای آرمچیر و زیگزاگ. ب) نحوه قرار گرفتن نواحی گرم و سرد در شبیه سازی. پ) چندلایهی گرافینی. ت) افت و خیز دمای سامانه در مجاورت دمای انتخاب شده در زمان شبیه سازی. ث) رسانش گرمایی چندلایههای گرافینی زیگزاگ (قرمز) و آرمچیر (آبی) بر حسب تعداد لایهها در دمای T=300 K.

پش کفتار

با کاهش اندازه ی وسایل الکتریکی و مکانیکی به نانومتر، ترابرد گرما از لحاظ کارکرد و طول عمر وسایل اهمیت زیادی دارد. از این رو در سالهای اخیر پژوهشگران تحقیقات گسترده ای بر روی رفتار حرارتی نانومواد انجام داده اند. ویژگیهای منحصر بفرد الکتریکی، گرمایی و مکانیکی گرافین، این ماده را به یک ساختار جذاب در زمینه تحقیقات تجربی و نظری تبدیل کرده است. نتایج بررسیهای تجربی و محاسباتی نشان داده اند که ساختارهای گرافینی از جمله نانونوار گرافینی دارای رسانش گرمایی قابل توجهی هستند [۱و۲]. نظم بلوری زیاد، طول پویش آزاد میانگین بلند و سرعت بالای فونونها از جمله عوامل مثبت تاثیرگذار بر رسانش گرمایی آنهاست [۳]. فونونها نقش عمده ای در رسانش گرمایی بر عهده دارند. بررسیها نشان داده اند که طول پویش آزاد میانگین فونونهای گرمایی در نانونوارها از مرتبهی میکرومتر تخمین زده شده است، ولی این طول به دلیل پراکندگیهای فونونی ناشی از برهمکنشهای فونون –فونون، فونون –مرز و فونون فونون میزد و فونون انقص کاهش می یابد [۳].

وش

در این پژوهش با استفاده از روش شبیهسازی دینامیک ملکولی بستگی رسانش گرمایی نانونوار گرافینی به افزایش تعداد لایههای نانونوار را با هر دو نوع لبه زیگزاگ و آرمچیر بررسی نمودهایم. از پتانسیل ترسوف به منظور بیان اندرکنشهای بین اتمی استفاده شده است. همچنین از روش غیرتعادلی مولر-پلث که بر پایه قانون فوریه می باشد برای ایجاد شار حرارتی بهره می بریم. در این روش نخست کل نانولوله را به کمک یک دمایای مناسب مانند دمایای نوز-هوور در دمای T به تعادل میرسانیم. سپس نانولوله را به لایههایی با ضخامت برابر بخش بندی می کنیم و شرایط مرزی دورهای را برای شبیه سازی ساختار به کار می گیریم. لایه های نخست در دو انتها را به عنوان لایهی واسطه برای جلوگیری از بازتاب انرژی گرمایی در نظر می گیریم. دمای لایه بعدی را در هر سو ثابت نگه میداریم. یکی از این لایهها با دمای ثابت Thot=T+∆T در یک سو نقش چشمهی گرمایی را بازی میکند و دیگری با دمای ثابت Tcold=T-∆T در سوی دیگر چاهک گرما خواهد بود. برای ثابت نگه داشتن دمای چشمه و چاهک در هر گام زمانی t مقدار گEhot,t انرژی به چشمه افزوده و مقدار ΔEcold,t انرژی از چاهک می کاهیم.